

信頼性試験結果

製品名 : S-8252xx-M6TxU

搭載パッケージ : SOT-23-6

No.	試験名	試験条件	時間	r/n	故障判定基準
1	高温バイアス	Ta=125 °C V _{DD} = V _{abs max.} ×0.9	1000 h	0/22	製品規格を満足すること
2	#1 高温高湿バイアス	Ta=85 °C RH=85 % V _{DD} = V _{abs max.} ×0.9	1000 h	0/22	製品規格を満足すること
3	#1 プレッシャ クッカ・バイアス	Ta=125 °C RH=85 % P=2×10 ⁵ Pa V _{DD} = V _{abs max.} ×0.9	100 h	0/22	製品規格を満足すること
4	高温保存	Ta=150 °C	1000 h	0/22	製品規格を満足すること
5	低温保存	Ta=-65 °C	1000 h	0/22	製品規格を満足すること
6	#1 温度サイクル (気相)	Ta=150 °C ⇔ -65 °C 各 30 分	200 cycles	0/22	製品規格を満足すること
7	#1 熱 衝 撃 (液相)	Ta=150 °C ⇔ -65 °C 各 5 分	100 cycles	0/22	製品規格を満足すること
8	はんだ耐熱性 1 (リフロー)	T=260 °C 10s	3 回	0/22	製品規格を満足すること 外観上、異常がなきこと
9	はんだ耐熱性 2 (はんだゴテ)	T=380 °C 5s (はんだコテ先温度)	2 回	0/22	製品規格を満足すること 外観上、異常がなきこと
10	#2 はんだ付け性	T=230 °C はんだ材 : Sn-3.0Ag-0.5Cu	3 s	0/11	ゼロクロスタイムが 3 秒以内 であること 半田浸漬部分の 95%以上が 新しい半田で覆われること
11	ウイスカ 1 (室温放置)	Ta=25±3°C RH=40~70%	3ヶ月	0/10	ウイスカサイズが 50 μm 以下 であること
12	ウイスカ 2 (温度サイクル)	Ta=85 °C ⇔ -40 °C 各 30 分	1000 cycles	0/10	ウイスカサイズが 50 μm 以下 であること
13	ウイスカ 3 (高温高湿放置)	Ta=60 °C RH=93 %	2000h	0/10	ウイスカサイズが 50 μm 以下 であること
14	はんだ接合強度 (せん断強度)	Ta=125 °C ⇔ -40 °C 各 30 分 はんだ材 : Sn-3.0Ag-0.5Cu	2000 cycles	0/5	初期強度値の 50%以上の 強度を維持すること
15	リード引っ張り強度	引張力 ; 2.5N	30 s	0/11	リードが脱落しないこと
16	リード曲げ強度	引張力 ; 1.25N 45 度折り曲げ	2 回	0/11	リードが脱落しないこと
17	静電耐圧 1 (HBM)	V=±2000 V C=100 pF R=1.5 kΩ V _{DD} 基準 V _{SS} 基準 ±印加 各 5 個	5 回	0/5 合計 20 個	製品規格を満足すること
18	静電耐圧 2 (MM)	V=±200 V C=200 pF R=0Ω V _{DD} 基準 V _{SS} 基準 ±印加 各 5 個	3 回	0/5 合計 20 個	製品規格を満足すること
19	ラッチアップ強度	±100 mA (クランプ電圧 V _{opr max.}) 10 ms パルス V _{DD} = V _{opr max.}	1 回	0/5	ラッチアップしないこと

注)V_{abs max.}=絶対最大定格 V_{opr max.}=最大動作電圧

#1、2 : 前処理を実施後、シリーズに試験を実施する。

セイコーインスツル (株) 半導体品質保証部

前 処 理 (#1)		
高温放置	吸湿処理	熱 処 理
Ta=125 °C t=24 h	Ta=85 °C RH=85 % t=168 h	赤外線リフロー3回 T=260 °C t=10 s

前 処 理 (#2)		
高温放置	吸湿処理	熱処理
Ta=125 °C t=24 h	Ta=105 °C RH=100% t=8 h	—